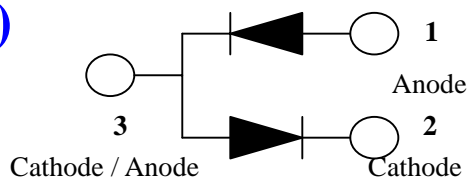




## Switching Diode (FHD99)



### 开关二极管

MAXIMUM RATINGS 最大额定值

Rating 额定值	Symbol 符号	Value 值	Unit 单位
Continuous Reverse Voltage 连续反向电压	$V_R$	70	Vdc
Peak Forward Current 正向峰值电流	$I_F$	200	mAdc
Peak Forward Surge Current 正向最大浪涌电流	$I_{FM(surge)}$	500	mAdc

### THERMAL CHARACTERISTICS 热特性

Characteristic 特性	Symbol 符号	Max 最大值	Unit 单位
Total Device Dissipation FR-5 Board(1) $T_A=25$	$P_D$	225	mW
Total Device Dissipation Alumina Substrate,(2) $T_A=25$ 总耗散功率 氧化铝衬底	$P_D$	300	mW
Junction and Storage Temperature 结温和储存温度	$T_J, T_{stg}$	150 , -55 to +150	

### DEVICE MARKING 打标

FHD99=A7

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性( $T_A=25$  unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25 )

Characteristic 特性	Symbol 符号	Min 最小值	Max 最大值	Unit 单位
-------------------	-----------	---------	---------	---------

### OFF CHARACTERISTICS 截止电特性

Reverse Voltage Leakage Current 反向漏电流( $V_R=70Vdc$ ) ( $V_R=70Vdc, T_J=150$ ) ( $V_R=25Vdc, T_J=150$ )	$I_R$	—	2.5 50 30	$\mu A_{dc}$
Reverse Breakdown Voltage 反向击穿电压( $I_{BR}=100 \mu A_{dc}$ )	$V_{(BR)}$	70	—	Vdc
Forward Voltage 正向电压 ( $I_F=1mA_{dc}$ ) ( $I_F=10mA_{dc}$ ) ( $I_F=50mA_{dc}$ ) ( $I_F=150mA_{dc}$ )	$V_F$	—	715 855 1000 1250	mVdc
Diode Capacitance 电容( $V_R=0, f=1.0MHz$ )	$C_D$	—	2.0	pF
Forward Recovery Voltage 正向恢复电压( $I_F=10mA_{dc}, t_r=20ns$ )	$V_{FR}$	—	1.75	Vdc
Reverse Recovery Time 反向恢复时间( $I_F=I_R=10mA_{dc}, R_L=50$ )	$t_{rr}$	—	6.0	ns

- FR-5=1.0 × 0.75 × 0.062 in.
- Alumina=0.4 × 0.3 × 0.024 in. 99.5% alumina.